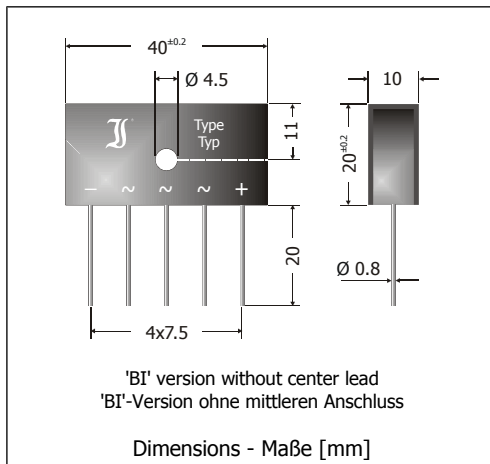


BI6-8 ... BI6-12, DBI6-8 ... DBI6-12
**Single/Three-Phase Si-Bridge-Rectifiers
Ein-/Dreiphasen-Si-Brückengleichrichter**

Version 2013-10-02



Nominal current Nennstrom	6 A
Alternating input voltage Eingangswchelsspannung	560, 800 V
Metal case Metallgehäuse	40 x 20 x 10 [mm]
Weight approx. – Gewicht ca.	35 g
Compound has classification UL94V-0 Vergussmasse nach UL94V-0 klassifiziert	
Standard packaging bulk Standard Lieferform lose im Karton	



Recognized Product – Underwriters Laboratories Inc.® File E175067
Anerkanntes Produkt – Underwriters Laboratories Inc.® Nr. E175067

Maximum ratings
Grenzwerte

Type Typ ¹⁾	Max. alternating input voltage Max. Eingangswchelsspannung V_{VRMS} [V]	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzenspersspannung V_{RRM} [V] ²⁾
BI6-8	1~	560
DBI6-8	3~	560
BI6-12	1~	800
DBI6-12	3~	800

Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom	$f > 15$ Hz	I_{FRM}	30 A ³⁾
Peak forward surge current 50 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50 Hz Sinus-Halbwell	$T_A = 25^\circ\text{C}$	I_{FSM}	125 A
Peak forward surge current 60 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 60 Hz Sinus-Halbwell	$T_A = 25^\circ\text{C}$	I_{FSM}	135 A
Rating for fusing, $t < 10$ ms Grenzlastintegral, $t < 10$ ms	$T_A = 25^\circ\text{C}$	i^2t	78 A ² s
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_j T_s	-50...+150°C -50...+150°C

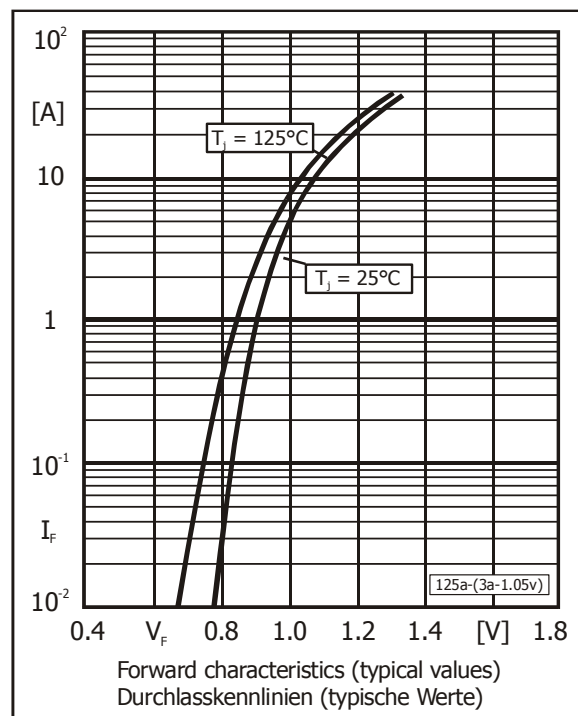
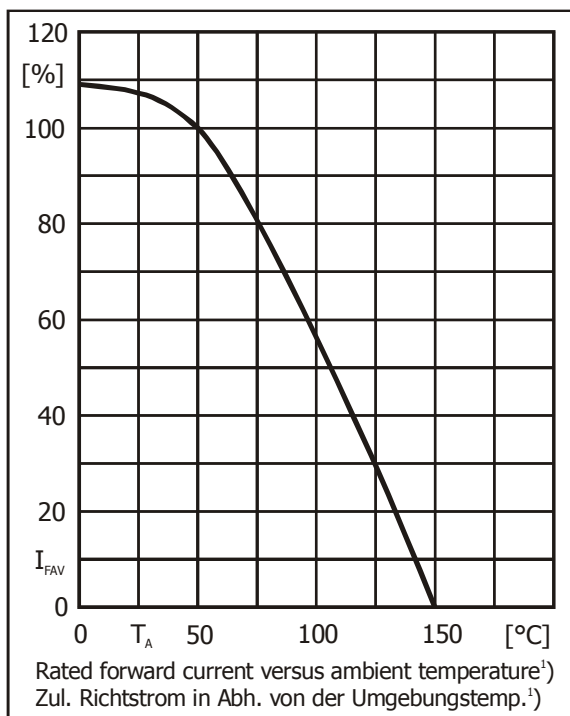
1 'BI' designates the single phase version, 'DBI' the three phase version
'BI' bezeichnet die Einphasen-Version, 'DBI' die Dreiphasen-Version

2 Valid per diode – Gültig pro Diode

3 Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 5 mm from case
Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 5 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

Characteristics
Kennwerte

Max. current without cooling fin Dauergrenzstrom ohne Kühlblech	$T_A = 50^\circ\text{C}$	I_{FAV}	2.0 A
Max. current with cooling fin 300 cm ² Dauergrenzstrom mit Kühlblech 300 cm ²	$T_A = 50^\circ\text{C}$	I_{FAV}	6 A
Forward voltage Durchlass-Spannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $I_F = 3 \text{ A}$	V_F	< 1.05 V ⁴⁾
Leakage current – Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $V_R = V_{RRM}$	I_R	< 10 μA
Isolation voltage terminals to case Isolationsspannung Anschlüsse zum Gehäuse		V_{ISO}	> 2500 V
Thermal resistance junction to case Wärmewiderstand Sperrschicht – Gehäuse		R_{thc}	< 4 K/W
Admissible torque for mounting Zulässiges Anzugsdrehmoment		M4	18 ± 10% lb.in. 2 ± 10% Nm



4 Valid for one diode – Gültig pro Diode